

## **Los empleados de KIOXIA reciben el Premio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón**

Tokio, Japón, 19 de abril de 2023 - KIOXIA Corporation, líder mundial en soluciones de memoria, anunció hoy que sus empleados recibieron el Premio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología por su invención del dispositivo de memoria flash tridimensional de alta densidad y su método de fabricación, que aumenta enormemente la capacidad de memoria y reduce los costes de fabricación.

El premio anual es otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología a personas que hayan realizado logros sobresalientes en investigación y desarrollo y que hayan promovido la comprensión de la ciencia y la tecnología en Japón.

### **Galardonados de KIOXIA**

- Ryota Katsumata, asistente del director general, Centro de Desarrollo de la Memoria Avanzada, División de la Memoria
- Masaru Kito, gerente de grupo, Centro de Desarrollo de Memoria Avanzada, División de Memoria
- Hideaki Aochi, experto superior, Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Dispositivos, Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Memoria
- Masaru Kido, especialista jefe, División de Estrategia de Desarrollo de la Memoria
- Hiroyasu Tanaka, especialista jefe, División de Estrategia de Desarrollo de la Memoria

### **Resumen de la tecnología galardonada**

La memoria flash se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones con el fin de almacenar datos, incluidos los teléfonos inteligentes y los centros de datos, y se espera que la demanda continúe creciendo.

La galardonada tecnología de memoria flash tridimensional es un enfoque innovador que simplificado enormemente el proceso de fabricación para apilar las células de memoria verticalmente y para lograr la memoria flash tridimensional de alta densidad. Mientras que el apilamiento convencional requería reiterados procesos de deposición y patrón para la fabricación de matrices de células de memoria, esta tecnología primero apila los materiales para las células de memoria y luego hace cada célula simultáneamente utilizando un proceso de patrón único, reduciendo significativamente los pasos de procesamiento. A medida que la tecnología de miniaturización empleada en la memoria flash bidimensional convencional se acerca a sus límites físicos, la tecnología de memoria flash tridimensional de alta capacidad y alto rendimiento se aplica cada vez más en los productos líderes del mercado. Tras comercializar la memoria flash tridimensional BiCS FLASH™ en 2015, KIOXIA ha estado trabajando para aumentar la densidad de apilamiento. El mes pasado, KIOXIA anunció su memoria flash tridimensional BiCS FLASH™ de alta capacidad y alto rendimiento de 218 capas.

Esta tecnología de memoria flash tridimensional también ha sido reconocida con el Premio Imperial de Invención del Concurso Nacional de Invención de 2020 y ha recibido el Premio Andrew S. Grove del IEEE de 2021.

Guiada por su misión de «elevar el mundo con 'memoria», KIOXIA está comprometida con su investigación y desarrollo tecnológico que aporta valor a las personas de todo el mundo.

La información contenida en este documento, incluidos los precios y las especificaciones de los productos, el contenido de los servicios y la información de contacto, es correcta en la fecha del anuncio, pero está sujeta a cambios sin previo aviso.